

課題番号 : F-16-KT-0089  
利用形態 : 技術相談  
利用課題名(日本語) : MEMS デバイス試作に関して  
Program Title (English) : Fabrication of MEMS device  
利用者名(日本語) : 東 昭弘  
Username (English) : Akihiro Higashi  
所属名(日本語) : 株式会社九州セミコンダクターKAW  
Affiliation (English) : Kyushu Semiconductor KAW Co., Ltd.

## 1. 概要(Summary)

(相談内容)

6 インチ Si ウェハでの SiO<sub>2</sub> エッチングに関して京都大学ナノテクノロジーハブ拠点を訪問し技術相談を行った。

(希望利用装置)

- ・各種ドライエッチング装置

(回答)

京大から全体プロセスの説明受け、前後プロセスを考慮していただき、ナノハブ保有の各種ドライエッチング装置の特性について説明していただいた。その結果、技術代行として Si ウェハ上の P-CVD で形成した SiO<sub>2</sub> エッチング加工を実施することになった。なお、エッチング前後の加工(金属成膜およびパターニング)は弊社で実施することに同意をいただいた。

SiO<sub>2</sub> 上に形成した金属膜への SiO<sub>2</sub> エッチングの影響、エッチング深さ、パターンサイズの公差等に議論を重ねた。その結果、エッチング装置としては、ドライエッチング装置および深堀りドライエッチング装置を選択し、先行実験を当ハブで実施した後、装置絞込みを行い試作代行として H29 年度 5 月を目処に利用開始することになった。

## 2. 実験(Experimental)

技術相談のため割愛。

## 3. 結果と考察(Results and Discussion)

H28 年度の装置利用なし。

## 4. その他・特記事項(Others)

技術相談のため割愛。